

## 产品概览

### FDMS86181: N 沟道, 屏蔽门极, PowerTrench® MOSFET, 100 V, 124A, 4.2mΩ

欲看完整文档, 请参阅数据表。

此 N 沟道 MV MOSFET 是使用先进的 PowerTrench®工艺生产的, 该工艺结合了屏蔽门极技术。此工艺经过了优化, 可最大程度降低导通电阻, 同时可保持卓越的开关性能, 以及业内最佳的软体二极管。

### 特性

- 屏蔽栅极 MOSFET 技术
- 最大  $r_{DS(on)} = 4.2 \text{ m}\Omega$  ( $V_{GS} = 10 \text{ V}$ ,  $I_D = 44 \text{ A}$ )
- 最大  $r_{DS(on)} = 12 \text{ m}\Omega$  ( $V_{GS} = 6 \text{ V}$ ,  $I_D = 22 \text{ A}$ )
- ADD
- $Q_{rr}$  比其他 MOSFET 供应商低 50%
- 减少了开关噪音/EMI
- MSL1 强健封装设计
- 100% 经过 UIL 测试
- 符合 RoHS 标准

### 应用

- This product is general usage and suitable for many different applications.

### 器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS}^{(BR)}$ Min (V)	$V_{GS}^{Max}$ (V)	$V_{GS}^{(th)}$ Max (V)	$I_D^{Max}$ (A)	$P_D^{Max}$ (W)	$R_{DS(on)}^{n}^{Max}$ @ $V_{GS} = 2.5 \text{ V}$ (mΩ)	$R_{DS(on)}^{n}^{Max}$ @ $V_{GS} = 4.5 \text{ V}$ (mΩ)	$R_{DS(on)}^{n}^{Max}$ @ $V_{GS} = 10 \text{ V}$ (mΩ)	$Q_g^{Typ}$ @ $V_{GS} = 4.5 \text{ V}$ (nC)	$Q_g^{Typ}$ @ $V_{GS} = 10 \text{ V}$ (nC)	$C_{iss}^{Typ}$ (pF)	Package Type
FDMS86181	1.1865	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	N-Channel	Single	100	±20	4	124	125	-	-	4.2	-	27	2945	PQFN-8

欲了解更多信息, 请联系您当地的销售支援 [www.onsemi.cn](http://www.onsemi.cn)。

创建于: 7/28/2021